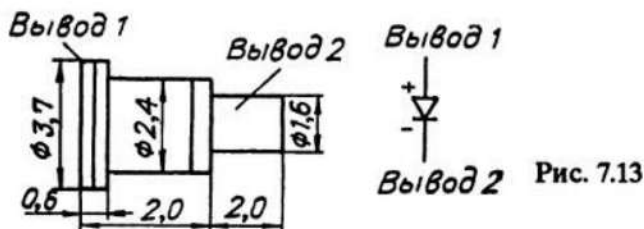


**3A725A, 3A725B, 3A725B, 3A725Г, 3A725Д,  
3A725E, AA725A, AA725B, AA725B, AA725Г,  
AA725Д, AA725E**

Диоды арсенидогаллиевые, мезазпитаксиальные, на эффекте Ганна, генераторные. Предназначены для применения в генераторах сантиметрового диапазона длин волн. Выпускаются в металлокерамическом корпусе типа КД-109 с жесткими выводами. Габаритный чертеж соответствует прибору 2A706 (рис.7.13). Тип диода приводится на групповой таре. Масса диода не более 0,15 г. Пример записи условного обозначения при заказе и в конструкторской документации: диод СВЧ 3A725A, аАО.339.132 ТУ; диод СВЧ AA725A, аАО.336.344 ТУ.



Электрические параметры

<b>Минимальная непрерывная мощность в рабочем диапазоне частот</b>	
3A725A, 3A725B, 3A725B, AA725A, AA725B, AA725B	200...270*...500 *мВт
3A725Г, 3A725Д, 3A725E, AA725Г, AA725Д, AA725E	300...380*...650* мВт
<b>Непрерывная выходная мощность на одной из частот рабочего диапазона</b>	
3A725A, 3A725B, 3A725B, AA725A, AA725B, AA725B	300*...400*...500* мВт
3A725Г, 3A725Д, 3A725E, AA725Г, AA725Д, AA725E	500*...560*...650* мВт
<b>Рабочий диапазон частот</b>	
3A725A, 3A725Г, AA725A, AA725Г	5...6 ГГц
3A725B, 3A725Д, AA725B, AA725Д	6...7 ГГц
3A725B, 3A725E, AA725B, 3A725E	7...8,25 ГГц
<b>Постоянное рабочее напряжение</b>	
11 В	
<b>Постоянный рабочий ток</b>	
3A725A, 3A725B, 3A725B, AA725A, AA725B, AA725B	0,8*...1,3*...1,5 А
3A725Г, 3A725Д, 3A725E, AA725Г, AA725Д, AA725E	0,8*...1,4*...2,0 А
<b>Сопротивление диода (I = 10 мА)</b>	
при T = +25°C	0,6...1,4*...3,0 Ом
T = +70°C	0,7...3,5 Ом
T = -60°C	0,3...2,8 Ом
<b>Емкость корпуса</b>	
не более 0,45 пФ	
<b>Индуктивность диода</b>	
не более 0,25 нГн	

**Предельные эксплуатационные данные**

Постоянное напряжение	11,2 В
Значение допустимого статического потенциала	1000 В
Температура корпуса	+85°C
Температура окружающей среды	-60 ... +70°C
Энергия активации механизмов отказа	1,86 эВ
Минимальная наработка при T = +70°C	15000 ч
Срок сохраняемости	25 лет

**Примечание:** Допускается работа диода при напряжении питания ниже номинального.

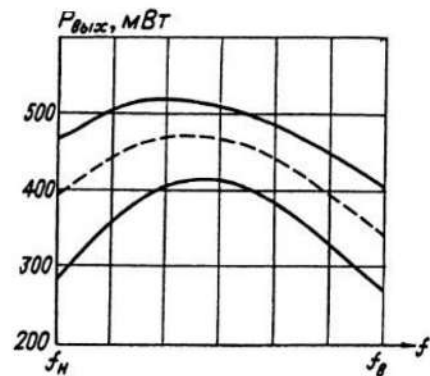


Рис.7.30. Зона возможных положений зависимости выходной мощности от частоты

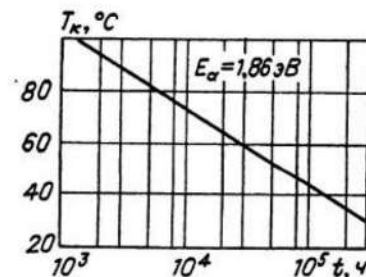


Рис.7.31. Зависимость минимальной наработки от температуры корпуса диода

Изготовитель: Томский завод при НИИ полупроводниковых приборов.